

圖 6-19 N⁺poly-Si photo and implant。

(3)高濃度 P 型多晶矽 (P⁺ Poly-Si) 之微影及三價的硼植入，完成之後再把光阻移除，如圖 6-20 所示。最後進行快速熱回火 (rapid thermal anneal, RTA) 的步驟，主要是為了防止硼滲透 (boron penetration)，因為硼在高溫中是一種很會擴散的原子，所以採用 RTA 改善之。

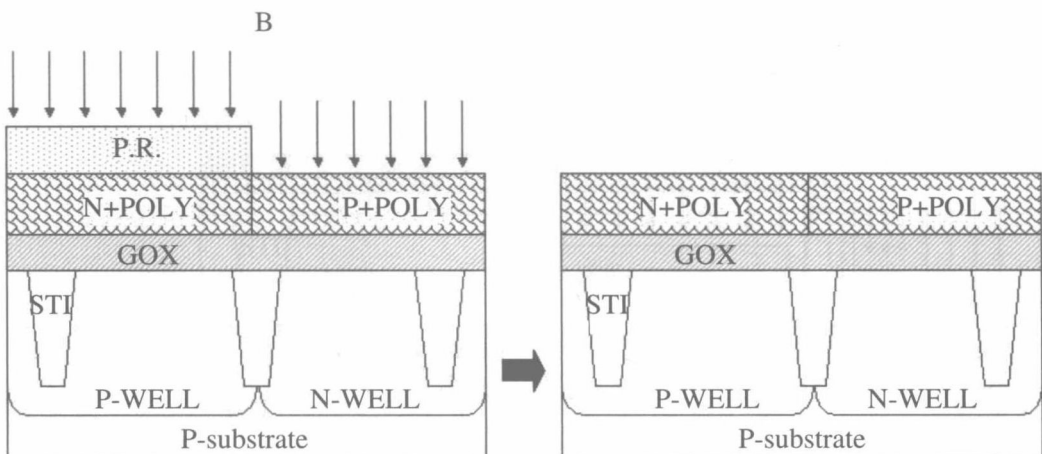


圖 6-20 P⁺ Poly-Si 製作流程。